

	<h2 style="color: red;">FQD2N30TM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD2N30TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD2N30TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD2N30TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N30TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 Ohm @ 850mA, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	130pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 1.7A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.7A (Tc)

FQD2N30TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD2N30TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FQD2N30TM E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQD2N100TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 1000V 1.6A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N30</b> FAI FQD2N30 FAI</p>	 <p><b>FQD2N40TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N30TF</b> VB FQD2N30TF VB</p>
 <p><b>FQD2N40TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N40TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N40TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD2N40</b> FAI FQD2N40 FAI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD2N30TM Datenblatt	FQD2N30TM-Datenblätter	FQD2N30TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD2N30TM
FQD2N30TM Electronic	FQD2N30TM-Komponenten	FQD2N30TM-Verteiler	FQD2N30TM-Bild	FQD2N30TM-Teil
FQD2N30TM Preis	FQD2N30TM Hersteller	FQD2N30TM Bild	FQD2N30TM Aktie	FQD2N30TM Inventar
FQD2N30TM Neu	FQD2N30TM Original	FQD2N30TM garantiert	FQD2N30TM RFQ	FQD2N30TM Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited